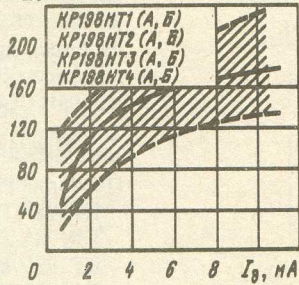


$\Delta U_{БЭ}, мВ$ 

Зависимость разности прямых напряжений база—эмиттер транзисторов, входящих в состав микросхем (дифференциальной пары), от температуры окружающей среды при $\Sigma I_3 = 0,5 \text{ мА}$, $T = +25^\circ \text{С}$. Заштрихована область разброса значений параметра для 95% микросхем. Сплошной линией показана типовая зависимость

 $h_{21Б}$ 

Зависимости коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером транзисторов, входящих в состав микросхем, от тока эмиттера при $U_{КБ} = 3 \text{ В}$. Заштрихована область разброса значений параметра для 95% микросхем. Сплошной линией показана типовая зависимость

 $\Delta h_{21Б}$ 

Зависимости разности статических коэффициентов передачи тока в схеме с общим эмиттером дифференциальной пары транзисторов, входящих в состав микросхем, от температуры окружающей среды

 $h_{21Б}$ 

Зависимость статического коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером транзисторов, входящих в состав микросхем, от температуры окружающей среды

 $I_{КБ0}, \text{мкА}$ 

Зависимости обратного тока коллектора транзисторов, входящих в состав микросхем, от температуры окружающей среды. Заштрихована область разброса значений параметра для 95% микросхем. Сплошной линией показана типовая зависимость

 $U_{КЭ \text{ нас}}, \text{В}$ 

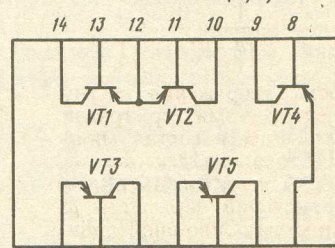
Зависимость напряжения насыщения коллектор—эмиттер транзисторов, входящих в состав микросхемы KP198HT3А, от тока эмиттера. Заштрихована область разброса значений параметров для 95% микросхем. Сплошной линией показана типовая зависимость

**KP198HT5A, KP198HT5B,
KP198HT6A, KP198HT6B,
KP198HT7A, KP198HT7B,
KP198HT8A, KP198HT8B**

Микросхемы представляют собой матрицы $p-n-p$ транзисторов. Различаются числом транзисторов, входящих в состав матрицы. Микросхемы KP198HT5A, KP198HT5B содержат 5 транзисторов $p-n-p$; KP198HT6A, KP198HT6B, KP198HT7A, KP198HT7B—4; KP198HT8A, KP198HT8B—3.

Корпус типа 201.14-1 (см. KP198HT1—KP198HT4). Масса не более 1,2 г.

KP198HT5(A, B)



справедливо для
KP198HT5 A, B